

図，表，参考文献作成上の注意

1. 図表（含：グラフ，写真）の説明文，図表内の説明用語等は全て英文とし，フォントは，Helvetica，中ゴシック等のゴシック系（英文字）またはSymbol（ギリシャ文字）を使用ください。
 2. 説明文，説明用語は，最初の文字のみ大文字とし，2番目以降は小文字としてください（ただし，固有名詞は除く）。
 3. 図表は，原則として，著者作成のものをそのまま使用しますので，説明用語の誤記がないよう十分に留意ください。
 4. グラフの縦軸/横軸は，名称および単位を必ず指定し，適切な間隔で目盛を入れてください。ただし，グラフ内には目盛線を入れないこと。
 5. 表は横罫線のみ使用して作成ください。縦罫線は使用しないこと。
 6. 写真は，焼き付けた陽画またはJ P E G形式で保存したファイルを提出ください。
 7. 他の文献より引用したものは，説明文の右肩に参考文献番号を入れてください。
 8. ホームページ，カタログ等は参考文献に入れず，脚注としてください。
 9. 図表作成に使用されるアプリケーションソフトによっては，当方のパソコン環境で開けない場合もありますので，スキャナでの読み取りに耐える鮮明な図表のハードコピーを原稿に添付ください。
- 以下に，図表のサンプルを示します。

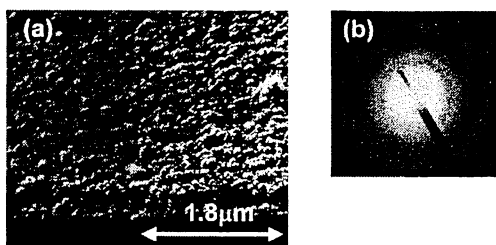


Fig. 4 (a) SEM image of a film prepared on a substrate at T_s of 300 °C with a 308 nm beam at a fluence of 0.2 $\text{Jcm}^{-2}\text{pulse}^{-1}$ and (b) the electron diffraction pattern.

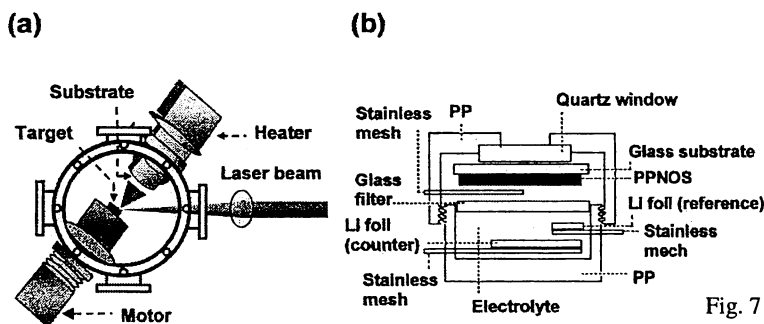


Fig. 1 (a) Schematic representation of the experimental set up for ELA and (b) the cell assembly for lithium ion doping.

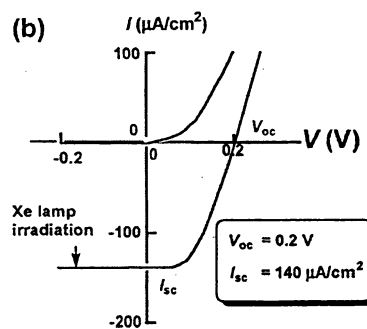
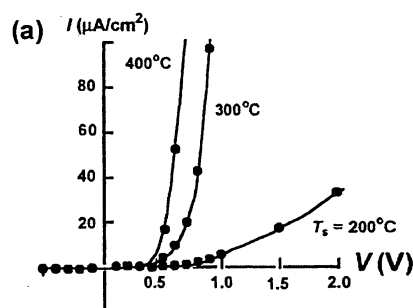


Fig. 7 (a) Dark current-voltage characteristics of a n-Si/PPNOS heterojunction prepared at T_s of 200, 300 and 400 °C and (b) current versus voltage curves in the dark and under illumination for the heterojunction prepared at T_s of 400 °C.

Table 1 Control of electric/electronic properties by selecting ablation conditions.

Wavelength (nm)	Fluence ($\text{Jcm}^{-2}\text{pulse}^{-1}$)	T_s (°C)	Electric cond. (Scm^{-1})	Thermo electric power (μVK^{-1})	Carrier
351	0.2	20	$10^{-6} - 10^{-5}$	-90	electron
308	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		electron
248	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		hole
193	0.2	20	$10^{-5} - 10^{-4}$		hole
308	0.5	20	$10^{-4} - 10^{-3}$		hole
308	4.0	20	10^{-3}		hole